

2N5883 2N5884 PNP
2N5885 2N5886 NPN

**COMPLEMENTARY SILICON
POWER TRANSISTORS**



TO-3 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N5883, 2N5885 series types are complementary silicon epitaxial base transistors designed for power amplifier and switching applications.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: ($T_C=25^{\circ}\text{C}$)

Collector-Base Voltage
Collector-Emitter Voltage
Emitter-Base Voltage
Continuous Collector Current
Peak Collector Current
Continuous Base Current
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL	2N5883	2N5884	UNITS
	2N5885	2N5886	
V_{CB0}	60	80	V
V_{CE0}	60	80	V
V_{EBO}		5.0	V
I_C		25	A
I_{CM}		50	A
I_B		7.5	A
P_D		200	W
T_J, T_{stg}		-65 to +200	$^{\circ}\text{C}$
θ_{JC}		0.875	$^{\circ}\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_C=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_{CBO}	$V_{CB}=\text{Rated } V_{CB0}$		1.0	mA
I_{CEO}	$V_{CE}=\frac{1}{2}\text{Rated } V_{CE0}$		2.0	mA
I_{CEX}	$V_{CE}=\text{Rated } V_{CE0}, V_{BE}=1.5\text{V}$		1.0	mA
I_{CEX}	$V_{CE}=\text{Rated } V_{CE0}, V_{BE}=1.5\text{V}, T_C=150^{\circ}\text{C}$		10	mA
I_{EBO}	$V_{EB}=5.0\text{V}$		1.0	mA
BV_{CEO}	$I_C=200\text{mA}$ (2N5883, 2N5885)	60		V
BV_{CEO}	$I_C=200\text{mA}$ (2N5884, 2N5886)	80		V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=15\text{A}, I_B=1.5\text{A}$		1.0	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=25\text{A}, I_B=6.25\text{A}$		4.0	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=25\text{A}, I_B=6.25\text{A}$		2.5	V
$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=4.0\text{V}, I_C=10\text{A}$		1.5	V
h_{FE}	$V_{CE}=4.0\text{V}, I_C=3.0\text{A}$	35		
h_{FE}	$V_{CE}=4.0\text{V}, I_C=10\text{A}$	20	100	
h_{FE}	$V_{CE}=4.0\text{V}, I_C=25\text{A}$	4.0		
f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=1.0\text{A}, f=1.0\text{MHz}$	4.0		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$ (2N5883, 2N5885)		1000	pF
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$ (2N5884, 2N5886)		500	pF
h_{fe}	$V_{CE}=4.0\text{V}, I_C=3.0\text{A}, f=1.0\text{kHz}$	20		
t_r	$V_{CC}=30\text{V}, I_C=10\text{A}, I_{B1}=I_{B2}=1.0\text{A}$		0.7	μs
t_s	$V_{CC}=30\text{V}, I_C=10\text{A}, I_{B1}=I_{B2}=1.0\text{A}$		1.0	μs
t_f	$V_{CC}=30\text{V}, I_C=10\text{A}, I_{B1}=I_{B2}=1.0\text{A}$		0.8	μs

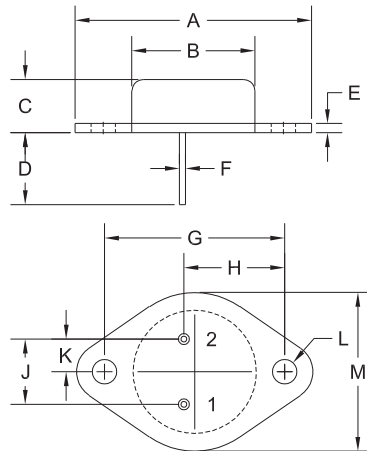
R1 (4-December 2012)

2N5883 2N5884 PNP
2N5885 2N5886 NPN

**COMPLEMENTARY SILICON
POWER TRANSISTORS**



TO-3 CASE - MECHANICAL OUTLINE



DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.516	1.573	38.50	39.96
B (DIA)	0.748	0.875	19.00	22.23
C	0.250	0.450	6.35	11.43
D	0.433	0.516	11.00	13.10
E	0.054	0.065	1.38	1.65
F	0.035	0.045	0.90	1.15
G	1.177	1.197	29.90	30.40
H	0.650	0.681	16.50	17.30
J	0.420	0.440	10.67	11.18
K	0.205	0.225	5.21	5.72
L (DIA)	0.151	0.172	3.84	4.36
M	0.984	1.050	25.00	26.67

TO-3 (REV: R2)

R2

LEAD CODE:

1) Base

2) Emitter

Case) Collector

MARKING:

FULL PART NUMBER

R1 (4-December 2012)

OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2nd day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

REQUESTING PRODUCT PLATING

1. If requesting Tin/Lead plated devices, add the suffix " TIN/LEAD" to the part number when ordering (example: 2N2222A TIN/LEAD).
2. If requesting Lead (Pb) Free plated devices, add the suffix " PBFREE" to the part number when ordering (example: 2N2222A PBFREE).

CONTACT US

Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.
145 Adams Avenue
Hauppauge, NY 11788 USA
Main Tel: (631) 435-1110
Main Fax: (631) 435-1824
Support Team Fax: (631) 435-3388
www.centrasemi.com

Worldwide Field Representatives:
www.centrasemi.com/wwreps

Worldwide Distributors:
www.centrasemi.com/wwdistributors

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: www.centrasemi.com/terms

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9